(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2003 年11 月6 日 (06.11.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/092061 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/268, 21/20

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/03366

(22) 国際出願日: 2003 年3 月19 日 (19.03.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-120312 2002 年4 月23 日 (23.04.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社液晶先端技術開発センター (ADVANCED LCD TECHNOLOGIES DEVELOPMENT CENTER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒244-0817 神奈川県 横浜市戸塚区 吉田町２９２番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 谷口 幸夫 (TANIGUCHI,Yukio) [JP/JP]; 〒244-0817 神奈川県 横浜市戸塚区 吉田町２９２番地 株式会社液晶先端技術開発センター内 Kanagawa (JP). 松村 正清 (MATSUMURA,Masakiyo) [JP/JP]; 〒244-0817 神奈川県 横浜市戸塚区 吉田町２９２番地 株式会社液晶先端技術開発センター内 Kanagawa (JP). 木村 嘉伸 (KIMURA,Yoshinobu) [JP/JP]; 〒244-0817 神奈川県 横浜市戸塚区 吉田町２９２番地 株式会社液晶先端技術開発センター内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE,Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関３丁目７番２号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

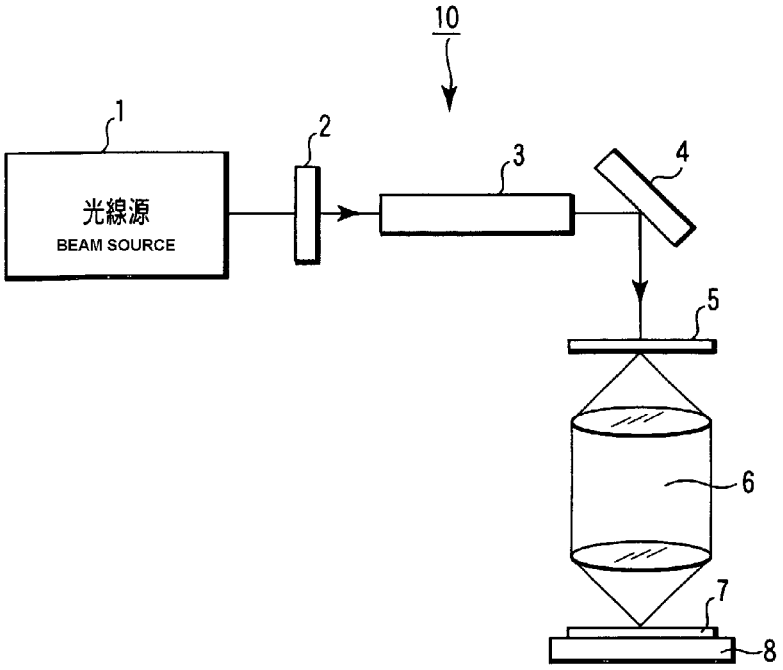
(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, SG, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: CRYSTALLIZATION DEVICE AND CRYSTALLIZATION METHOD, AND PHASE SHIFT MASK

(54) 発明の名称: 結晶化装置および結晶化方法、並びに位相シフトマスク



(57) Abstract: A crystallization device, wherein a phase shift mask (5) is disposed forward of a laser device (1) through a beam expander (2), a homogenizer (3), and a mirror (4), a processed substrate (7) is installed on a surface opposite to the phase shift mask (5) through an image formation optical system (6), and the processed substrate (7) is held at a specified position by using a substrate chuck (8) such as a vacuum chuck and an electrostatic chuck.

[続葉有]

WO 03/092061 A1

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: レーザ装置（１）の先にビームエキスパンダ（２）、ホモジナイザ（３）、ミラー（４）を介して位相シフトマスク（５）を配置し、結像光学系（６）を間に入れて位相シフトマスク（５）の対向面に被処理基板（７）を設置する。被処理基板（７）は、真空チャックや静電チャックなどの基板チャック（８）を用いて所定の位置に保持する。